



Communiqué de presse

KIOXIA et Sandisk présentent une technologie de mémoire flash 3D de nouvelle génération atteignant une vitesse d'interface NAND de 4,8 Go/s

Les deux entreprises présentent en avant-première une technologie de mémoire flash 3D de 10e génération, établissant une nouvelle référence en matière de performances, d'efficacité énergétique et de densité de bits

Allemagne, Düsseldorf, le 20 février 2025 – [KIOXIA Corporation](#) et Sandisk Corporation ont lancé une technologie de mémoire flash 3D de pointe, établissant la référence de l'industrie avec une vitesse d'interface NAND de 4,8 Gbit/s, une efficacité énergétique supérieure et une densité élevée.

Dévoilée à l'ISSCC 2025, la nouvelle innovation en matière de mémoire flash 3D, associée à la technologie révolutionnaire CBA (CMOS directly Bonded to Array)¹ de la société, intègre l'une des dernières normes d'interface, Toggle DDR6.0 de la mémoire flash NAND, et exploite le protocole SCA (Separate Command Address)², la nouvelle méthode de saisie d'adresses de commande de son interface, et la technologie PI-LTT (Power Isolated Low-Tapped Termination)³, qui est essentielle pour réduire davantage la consommation d'énergie.

En exploitant cette technologie haut débit unique, les entreprises espèrent que la nouvelle mémoire flash 3D améliorera de 33 % la vitesse de l'interface NAND par rapport à leur mémoire flash 3D de 8e génération actuellement en production de masse, atteignant une vitesse d'interface de 4,8 Go/s. La technologie permet également d'améliorer l'efficacité énergétique des entrées/sorties de données, réduisant la consommation d'énergie de 10 % pour l'entrée et de 34 % pour la sortie, trouvant ainsi un équilibre entre hautes performances et faible consommation d'énergie.



Lors de la présentation en avant-première de la mémoire flash 3D de 10e génération, les entreprises ont précisé qu'en élevant le nombre de couches de mémoire à 332 et qu'en optimisant le plan d'implantation pour accroître la densité planaire, la technologie améliore la densité de bits de 59 %.

« En plus de la nécessité d'augmenter l'efficacité énergétique dans les centres de données, une hausse considérable de la production de données devrait être notée sous l'impulsion des nouvelles applications basées sur la technologie de l'IA, à travers des opérations sophistiquées telles que l'inférence à la périphérie et l'application de techniques d'apprentissage par transfert qui renforcent les exigences en matière de stockage. », déclare Axel Stoermann, vice-président et directeur de la technologie chez KIOXIA Europe GmbH. « KIOXIA continue de jeter les bases en répondant à ces exigences de stockage de demain : plus de vitesses, de capacité et une consommation d'énergie inférieure. »

Alper Ilkbahar, vice-président directeur de la stratégie mondiale et de la technologie chez Sandisk, a déclaré : « À mesure que l'IA progresse, les besoins des clients en matière de mémoire se diversifient de plus en plus. À travers l'innovation technologique CBA, notre objectif est de lancer des produits offrant le meilleur mélange en termes de capacité, de vitesse, de performance et d'efficacité du capital pour répondre aux besoins de nos clients dans divers segments de marché.

KIOXIA et Sandisk ont également partagé leurs plans pour la prochaine mémoire flash 3D de 9e génération. Leur technologie CBA unique permet aux deux entreprises de combiner la nouvelle technologie CMOS avec une technologie de cellule de mémoire existante pour fournir des produits rentables, performants et à faible consommation. Les deux entreprises sont déterminées à développer des technologies de mémoire flash de pointe, à offrir des solutions sur mesure pour répondre aux besoins des clients et faire avancer la société numérique.

###



Remarques :

- 1: Technologie dans laquelle les plaquettes CMOS et les plaquettes de réseau cellulaire sont fabriquées séparément dans des conditions optimales, puis collées ensemble.
- 2: Technologie dans laquelle le bus de la saisie de commandes/d'adresses et le bus de transfert des données sont complètement séparés en différents bus et utilisés en parallèle. Le temps d'entrée/sortie des données est ainsi réduit.
- 3: Technologie dans laquelle des sources d'alimentation d'une tension 1,2 V existante et d'une tension inférieure supplémentaire sont utilisées pour alimenter l'interface NAND. C'est un moyen de réduire la consommation d'énergie lors de l'entrée/la sortie des données.

*1 Gbps correspond à 1 000 000 000 bits/seconde. Cette valeur est obtenue dans des conditions spécifiques à notre environnement de test, et peut varier selon les conditions d'utilisation.

*Les noms de sociétés, de produits et de services mentionnés ici peuvent être des marques de sociétés tierces.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations concernant les attentes relatives à la disponibilité, aux fonctionnalités et aux impacts de la technologie et des produits de Sandisk. Ces déclarations prospectives s'appuient sur les attentes actuelles de la direction et sont soumises à des risques et incertitudes susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations.

Les principaux risques et incertitudes susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives sont : les défis opérationnels, financiers et juridiques et les difficultés inhérentes à l'implémentation de la scission de l'activité Flash de Western Digital Corporation à Sandisk ; les résultats d'exploitation futurs de l'activité Flash autonome ; la question de l'effectivité de la scission selon les modalités et l'échéancier prévus ou son ineffectivité, sachant que les conditions de la scission peuvent ne pas être remplies, et qu'une entité gouvernementale peut interdire, retarder ou refuser d'accorder l'approbation nécessaire ; les avantages et les coûts prévus de la scission, notamment en cas de non concrétisation des avantages espérés dans les délais prévus, entièrement ou pas du tout ; les réactions défavorables potentielles ou les changements dans les relations avec la clientèle, les fournisseurs ou d'autres partenaires résultant de l'annonce et de l'effectivité de la scission ; les réactions de la concurrence à l'annonce ou à l'effectivité de la scission ; les coûts, obligations, frais ou dépenses imprévus résultant de la scission ; les litiges relatifs à la scission ; l'impossibilité de retenir les employés clés à la suite de la scission, la perturbation du temps consacré à la gestion des activités commerciales en cours en raison de la scission ; l'incidence



commercial des conflits géopolitiques ; et toute modification apportée aux conditions économiques générales et/ou spécifiques à l'industrie ; d'autres facteurs économiques, concurrentiels, juridiques, gouvernementaux, technologiques et autres susceptibles d'affecter la scission et d'autres risques et incertitudes énoncés dans la déclaration d'information finale jointe en tant que pièce 99.1 au formulaire 10 de la déclaration d'enregistrement de Sandisk Corporation déposée auprès de la SEC le 27 janvier 2025, et disponible sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent document, et Sandisk n'est pas tenue de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouvelles informations ou de nouveaux événements, sauf si la loi l'exige.

À propos de KIOXIA

KIOXIA leader mondial dans le domaine des solutions de mémoires, s'est engagée dans le développement, la production et la vente de mémoires flash et de solid-state drives (disques SSD). L'entreprise Toshiba Memory s'était détachée de la Toshiba Corporation en avril 2017, l'inventeur de la mémoire flash NAND en 1987. KIOXIA s'est engagée à changer le monde à travers les mémoires en proposant des produits, des services et des systèmes générant du choix et une valeur basée sur les mémoires pour la société. L'innovante technologie de mémoire flash 3D de KIOXIA, BiCS FLASH™, façonne l'avenir du stockage dans des applications à haute densité, notamment les smartphones haut de gamme, les PC, les systèmes automobiles, les centres de données et les systèmes d'intelligence artificielle générative. Visitez le [site web de KIOXIA](#)

À propos de Sandisk

Sandisk fournit des solutions de stockage Flash innovantes et des technologies de mémoire avancées qui répondent aux besoins des personnes et des entreprises à la croisée de leurs aspirations et aux besoins du moment, leur permettant d'avancer et de repousser les limites. Sandisk Corporation est une filiale à part entière de Western Digital (Nasdaq : WDC). Suivez Sandisk sur [Instagram](#), [Facebook](#), [X](#), [LinkedIn](#), [Youtube](#). Rejoignez [TeamSandisk](#) sur Instagram.

Coordonnées de Sandisk

Investisseurs : Investors@sandisk.com

Média : MediaInquiries@sandisk.com



Coordonnées de la publication :

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Allemagne

Tél. : +49 (0)211 368 77-0

E-mail : KIE-support@kioxia.com

Coordonnées pour les demandes d'information éditoriale :

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH

Tél. : +49 (0) 211 36877 382

E-mail : lena1.hoffmann@kioxia.com

Publié par :

Birgit Schöniger, Publitek

Tél. : +49 (0)172 617 8431

E-mail : birgit.schoeniger@publitek.com

Site web : www.publitek.com